

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-176727

(43)Date of publication of application : 02.07.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/027  
G01B 17/00  
G03F 7/20

(21)Application number : 09-341445

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 11.12.1997

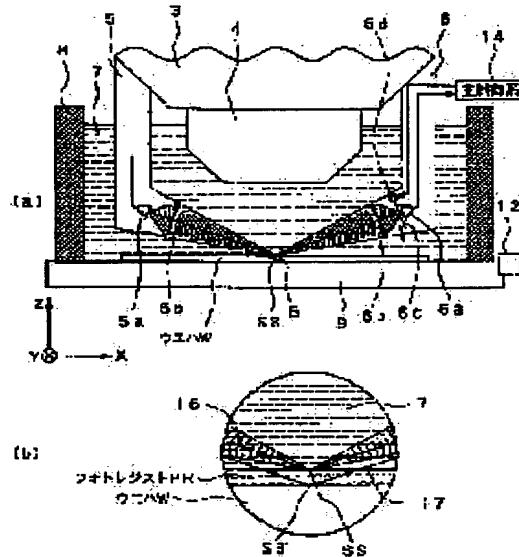
(72)Inventor : SHIRAISHI NAOMASA

## (54) PROJECTION ALIGNER

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To detect with high precision a position in an optical axis direction of a projection optical system on a surface of a substrate, even when wavelengths of aligned lights are substantially reduced and moreover the alignment is carried out in a liquid.

**SOLUTION:** A liquid 7 is supplied to a sidewall 8 so as to satisfy a gap between a lens 4 of a projection optical system which is closest to a wafer W and the wafer W. Ultrasonic waves are emitted from an ultrasonic emission system 5, and the ultrasonic waves reflected by an ultrasonic focusing position SS are received by an ultrasonic reception system 6. Based on a detection signal from the ultrasonic reception system 6, a defocusing amount from a best focusing position in a focusing position SS of ultrasonic waves is acquired. Based on the acquired defocusing amount, a sample pedestal 9 is driven in a Z-direction to control a focusing position.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-176727

(43)公開日 平成11年(1999)7月2日

(51)IntCl.<sup>6</sup>  
H 01 L 21/027  
G 01 B 17/00  
G 03 F 7/20

識別記号  
5 2 1

F I  
H 01 L 21/30 5 2 6 Z  
G 01 B 17/00 B  
G 03 F 7/20 5 2 1  
H 01 L 21/30 5 1 4 C

審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平9-341445

(22)出願日 平成9年(1997)12月11日

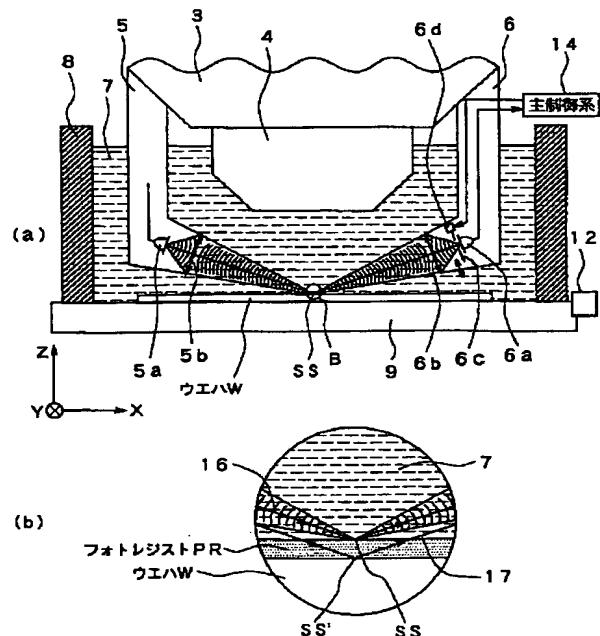
(71)出願人 000004112  
株式会社ニコン  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  
(72)発明者 白石 直正  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株  
式会社ニコン内  
(74)代理人 弁理士 大森 聰

(54)【発明の名称】 投影露光装置

(57)【要約】

【課題】 露光光を実質的に短波長化し、また、露光が液体中で行われる場合であっても、基板表面の投影光学系の光軸方向の位置を高精度に検出する。

【解決手段】 ウエハWに最も近い投影光学系のレンズ4とウエハWとの間を満たすように側壁8内に液体7を供給する。超音波射出系5から超音波を射出し、超音波集束位置SSにおいて反射した超音波を超音波受信系6により受信する。超音波受信系6からの検出信号に基づいて、超音波の集束位置SSにおけるベストフォーカス位置からのデフォーカス量を求める。求められたデフォーカス量に基づいて試料台9をZ方向に駆動し、フォーカス位置の制御を行う。



BEST AVAILABLE COPY

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 マスクパターンを投影光学系を介して基板上に転写する投影露光装置において、前記基板の表面に所定の液体を供給する液浸装置と、前記基板の表面に前記液体を介して超音波を送出し、前記表面で反射される超音波を検出することによって前記表面の前記投影光学系の光軸方向の位置を検出する超音波方式の面位置検出装置と、を備えたことを特徴とする投影露光装置。

【請求項2】 前記基板の表面に感光材料が塗布されている際に、前記面位置検出装置は、前記感光材料の表面の前記投影光学系の光軸方向の位置を検出することを特徴とする請求項1記載の投影露光装置。

【請求項3】 前記投影光学系の前記基板側の光学素子の先端部と前記基板の表面との間を満たすように前記液体が供給されることを特徴とする請求項1、又は2記載の投影露光装置。

【請求項4】 前記液体は、水、又は有機溶媒であることを特徴とする請求項1、2、又は3記載の投影露光装置。

【請求項5】 前記基板を保持して該基板を前記投影光学系の光軸に垂直な平面上で位置決めする基板ステージと、前記面位置検出装置の検出結果に基づいて前記基板の前記投影光学系の光軸方向の位置を制御する高さ制御ステ

$$R = k_1 \cdot \lambda / NA$$

$$\delta = k_2 \cdot \lambda / NA^2$$

ここで、 $\lambda$ は露光波長、NAは投影光学系の開口数、 $k_1$ 、 $k_2$ はプロセス係数である。同じ解像度を得る場合には短い波長の露光光を用いた方が大きな焦点深度を得ることができる。しかしながら、投影光学系に使用される透過性の光学部材（硝材）の分光透過特性を考慮すると、現時点ではArFエキシマレーザの193nmより短い波長の露光光を透過できると共に、比較的大きなレンズを形成できる均一な硝材はほとんどない。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】上記の如く従来の投影露光装置（投影光学系）では、ArFエキシマレーザの193nmより短い波長の露光光を使用することは困難である。そこで、実質的に露光波長を短くする方法として、液浸法が提案されている。これは、ウエハを所定の液体中に浸し、液体中の露光光の波長が、空気中の1/n倍（nは液体の屈折率で通常1.2～1.6程度）になることを利用して解像度を向上し、焦点深度を増大するというものである。

## 【0006】ところで、露光時には、露光範囲全体が投

$$\text{反射率} = \{ (1 - 1.7) / (1 + 1.7) \}^2 \times 100$$

$$= 6.7 (\%)$$

空気-フォトレジスト界面では、合焦検出用の光束の比

ージと、を備えたことを特徴とする請求項1～4の何れか一項記載の投影露光装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、半導体素子、液晶表示素子、又は薄膜磁気ヘッド等を製造するためのリソグラフィ工程に用いられる投影露光装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】半導体素子等を製造する際に、フォトマスクとしてのレチクルのパターンの像を投影光学系を介して、基板としてのレジストが塗布されたウエハ（又はガラスプレート等）上の各ショット領域に転写するステッパー型、又はステップ・アンド・スキャン方式等の投影露光装置が使用されている。

【0003】投影露光装置に備えられている投影光学系の解像度は、使用する露光波長が短く、投影光学系の開口数が大きいほど高くなる。そのため、集積回路の微細化に伴い投影露光装置で使用される露光波長は年々短波長化しており、投影光学系の開口数も増大してきている。そして、現在主流の露光波長は、ArFエキシマレーザの248nmであるが、更に短波長のArFエキシマレーザの193nmの使用も検討されている。

【0004】また、露光を行う際には、解像度と同様に焦点深度も重要なとなる。解像度R、及び焦点深度δはそれぞれ以下の式で表される。

$$(1)$$

$$(2)$$

影光学系の焦点深度の範囲内に入る必要があるため、投影露光装置には、合焦機構（オートフォーカス機構）が設けられている。これは、一般に露光すべきウエハの表面に斜入射で光ビームを入射し、その反射光を対面の光学系で受光してウエハ表面の合焦状態を検出し、ウエハを上下に移動して合焦位置へ追い込むというものである。

【0007】露光されるウエハ表面には感光膜（フォトレジスト）が塗布されており、このフォトレジストにパターンが転写される。そこで、このフォトレジスト表面を投影光学系の焦点位置に一致させることができ、フォトレジスト表面の位置を検出する必要がある。従来の投影露光装置では、ウエハが配置される空間は空気、又は窒素等の気体で満たされている。そして、例えば空気の屈折率は1であり、ウエハ表面に塗布されたフォトレジストの屈折率は、約1.7である。従って、空気-フォトレジスト界面における光の反射率は、フレネルの式より以下のように計算される。

$$(3)$$

較的多くが反射し、フォトレジスト表面の位置を検出す

ことができる。

【0008】しかし、液浸法を採用した投影露光装置の場合には、ウエハが配置される空間は液体で満たされる

$$\text{反射率} = \{ (1.3 - 1.7) / (1.3 + 1.7) \}^2 \times 100 \\ = 1.8 (\%)$$

水ーフォトトレジスト界面では、空気ーフォトトレジスト界面に比べ空間とフォトトレジストとの屈折率の差が著しく小さくなるため、合焦検出用の光束の反射率が低下し、フォトトレジスト表面の位置を正確に検出することが困難となる。

【0009】本発明は斯かる点に鑑み、露光光の波長を短波長化し、より微細なパターンを転写できる投影露光装置を提供することを目的とする。さらに、液体中で感光材料が塗布された基板上に露光が行われる場合であっても、その感光材料の表面の投影光学系の光軸方向の位置を高精度に検出することができる投影露光装置を提供することをも目的とする。

#### 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の投影露光装置は、マスク (R) のパターン像を投影光学系 (PL) を介して基板 (W) 上に転写する投影露光装置において、その基板 (W) の表面に所定の液体 (7) を供給する液浸装置 (2, 8) と、その基板 (W) の表面に液体 (7) を介して超音波を送出し、その表面で反射される超音波を検出することによってその表面のその投影光学系 (PL) の光軸方向の位置を検出する超音波方式の面位置検出装置 (5, 6) とを備えたものである。

【0011】斯かる本発明の投影露光装置によれば、マスク (R) のパターン像を液体 (7) を介して基板 (W) の表面に露光するため、基板表面における露光光の波長を空気中における波長の  $1/n$  倍 ( $n$  は液体 (7) の屈折率) に短波長化できる。また、超音波方式の面位置検出装置 (5, 6) により基板 (W) の表面の光軸方向の位置を高精度に検出するため、光学式の面位置検出装置では面位置の検出が困難な液体 (7) 中においても、その位置を高精度に検出することができる。

【0012】また、基板 (W) の表面に感光材料 (PR) が塗布されている際に、面位置検出装置 (5, 6) は、その感光材料 (PR) の表面の投影光学系 (3, 4) の光軸方向の位置を検出することが望ましい。この場合、投影光学系 (3, 4) の像面をその感光材料 (PR) の表面に合わせ込むことができる。また、投影光学系 (PL) の基板 (W) 側の光学素子 (4) の先端部とその基板 (W) の表面との間を満たすように液体 (7) が供給されることが望ましい。この場合、基板 (W) 表面における露光光の波長を、空気中における露光光の波長の  $1/n$  倍 ( $n$  は液体 (7) の屈折率) に短波長化できる。さらに、投影光学系 (PL) の鏡筒 (3) が液体 (7) に接触しないため、鏡筒 (3) が腐食しにくくなるという利点がある。

ことになる。例えば液体が水である場合、その屈折率は 1.3 であり、水ーフォトトレジスト界面における光の反射率は、フレネルの式より以下のように計算される。

#### (4)

【0013】また、その液体 (7) は、水 (屈折率 1.3)、又は有機溶媒 (例えばアルコール (エタノール (屈折率 1.36) 等)、セダー油 (屈折率 1.52) 等) である。この場合に液体 (7) として水を用いる場合には、その入手が容易であるという利点がある。また、液体 (7) として有機溶媒を用いる場合には、投影光学系 (PL) の鏡筒 (3) が腐食しにくくなるという利点がある。さらに、液体 (7) としてセダー油を用いる場合には、その屈折率が約 1.5 と大きく、露光光をより短波長化することができる。

【0014】また、基板 (W) を保持してこの基板 (W) を投影光学系 (PL) の光軸に垂直な平面上で位置決めする基板ステージ (10) と、面位置検出装置 (5, 6) の検出結果に基づいてその基板 (W) の投影光学系の光軸方向 (3, 4) の位置を制御する高さ制御ステージ (9) とを備えることが望ましい。この場合、投影光学系 (3, 4) の像面に対して基板 (W) の表面を高精度に合わせ込むことができる。

#### 【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例につき図1～図3を参照して説明する。図1 (a) は本例の投影露光装置の概略構成を示し、この図1 (a)において、露光光源としてのArFエキシマレーザ光源、オプティカル・インテグレータ、視野絞り、コンデンサレンズ等を含む照明光学系1から射出された波長193nmの紫外パルス光よりなる露光光ILは、レチクルRに設けられたパターンを照明する。レチクルRのパターンは、両側 (又はウエハ側に片側) テレセントリックな投影光学系PLを介して所定の投影倍率 $\beta$  ( $\beta$  は例えば  $1/4, 1/5$  等) でフォトトレジストPRが塗布されたウエハW上の露光領域に縮小投影される。なお、露光光ILとしては、KrFエキシマレーザ光 (波長248nm)、F<sub>2</sub>エキシマレーザ光 (波長157nm) や水銀ランプのi線 (波長365nm) 等を使用してもよい。以下、投影光学系PLの光軸AXに平行にZ軸を取り、Z軸に垂直な平面内で図1 (a) の紙面に垂直な方向に沿ってY軸を取り、紙面に平行な方向に沿ってX軸を取って説明する。

【0016】レチクルRはレチクルステージRST上に保持され、レチクルステージRSTにはX方向、Y方向、回転方向に微動できる機構が組み込まれている。レチクルステージRSTの2次元的な位置、及び回転角はレーザ干渉計 (不図示) によってリアルタイムに計測されている。一方、ウエハWはウエハホルダ (不図示) を介して試料台9上に保持され、試料台9はウエハWのフ

オーカス位置 (Z 方向の位置) 及び傾斜角を制御する Z ステージ 10 上に固定されている。試料台 9 上には円筒状の側壁 8 が設けられおり、その内部は液体 7 で満たされている。液体 7 は、ポンプ等からなる液体供給回収系 2 により、ノズル 2a を介して露光前に側壁 8 内に供給され、露光後に回収される。なお、本例の投影露光装置では液体 7 として水 (屈折率 1.3) を使用しており、光の波長は水中において空気中の 1/1.3 倍になるため、ArF エキシマレーザ (波長 193 nm) よりなる露光光の波長は実質的に約 148 nm に短波長化される。

【0017】また、投影光学系 PL の鏡筒 3 は金属製であり、液体 7 による腐食を防止するため、本例では、投影光学系 PL と液体 7 との接触部分は、ウエハ W に最も近いレンズ 4 のみとしている。また、投影光学系 PL の鏡筒 3 の側面には、超音波射出系 5 と超音波受信系 6 とによる焦点位置検出系 (以下「AF センサ 5, 6」と呼ぶ) が取り付けられている。

【0018】図 1 (b) は図 1 (a) の側壁 8 近傍の拡大図であり、この図 1 (b) において、側壁 8 にはウエハ W の試料台 9 上への搬送、又は試料台 9 からの搬出の際に使用する開閉自在の扉 8a が設けられている。また、液体供給回収系 2 のノズル 2a は、液体の供給、及び回収の際に上下に駆動することができる構成となっている。

【0019】図 1 (a) に戻り、Z ステージ 10 は投影光学系 PL の像面と平行な XY 平面に沿って移動する XY ステージ 11 上に固定され、XY ステージ 11 は不図示のベース上に載置されている。Z ステージ 10 は、ウエハ W のフォーカス位置 (Z 方向の位置)、及び傾斜角を制御してウエハ W 上のフォトレジスト PR 表面をオートフォーカス方式、及びオートレベリング方式で投影光学系 PL の像面に合わせ込み、XY ステージ 11 はウエハ W の X 方向、及び Y 方向の位置合わせを行う。試料台 9 (ウエハ W) の 2 次元的な位置、及び回転角は、移動鏡 12 の位置としてレーザ干渉計 13 によってリアルタイムに計測されている。この計測結果に基づいて主制御系 14 からウエハステージ駆動系 15 に制御情報が送られ、Z ステージ 10、XY ステージ 11 の動作が制御され、露光時にはウエハ W 上の各ショット領域が順次露光位置に移動し、レチクル R のパターンが各ショット領域へ露光転写される。

【0020】次に、本例の投影露光装置の AF センサ 5, 6 について説明する。図 2 (a) は、本例の投影光学系の下部近傍を拡大して示し、この図 2 (a) において、超音波射出系 5 には超音波発生素子 5a、及び超音波集束素子 5b が設けられている。圧電素子等からなる超音波発生素子 5a から射出された周波数 50 MHz ~ 200 MHz 程度の超音波は、超音波集束素子 5b によりウエハ W に塗布されたフォトレジスト PR 表面上の集

束位置 SS に集束され、集束位置 SS で反射して超音波受信系 6 に入射する。超音波受信系 6 には超音波受信素子 6a、超音波集束素子 6b、及び振動できる遮音板 6c が設けられており、超音波受信系 6 に入射した超音波は超音波集束素子 6b により集束され、遮音板 6c の開口を介して超音波受信素子 6a に入射する。超音波受信素子 6a の検出信号は主制御系 14 に供給される。なお、遮音板 6c の中央部には超音波を通過させる開口が設けられて、主制御系 14 が遮音板駆動機構 6d により遮音板 6c を横シフト (又は振動) させて超音波受信素子 6a の検出信号が最大になる位置を検出する。又は、遮音板 6c を振動させるのに同期した信号で超音波受信素子 6a の検出信号を同期検波してもよい。

【0021】図 2 (b) は、フォトレジスト PR 表面上の超音波の集束位置 SS 付近を拡大して示し、この図 2 (b) において、ウエハ W 上には感光用のフォトレジスト PR が塗布されている。従来の光学式で斜入射方式の AF センサによりフォトレジスト PR 表面上の位置 SS を検出しようとしても、液体 7 とフォトレジスト PR の屈折率が同程度で反射率が極めて低くなり、光は経路 17 に沿ってウエハ W の表面まで進むため、検出される位置 SS' はフォトレジスト PR の表面上に位置せず、投影光学系 PL の像面にはウエハ W の基板自体の表面が合わせ込まれる。本例の AF センサ 5, 6 の超音波は経路 16 に沿って進みフォトレジスト PR の表面で反射されるため、フォトレジスト PR 表面上の位置 SS が正確に検出され、高精度にフォトレジスト PR 表面を像面に合焦させることができる。

【0022】また、フォトレジスト PR 表面の Z 方向の位置は、従来の光学式で斜入射方式の AF センサと同様の原理によって超音波受信素子 6a 上での超音波の集束位置の横シフト量から検出される。即ち、ウエハ W が図 2 (b) 中の下方 (-Z 方向) にずれれば図 2 (a) の超音波受信素子 6a 上での集束位置が上方にずれ、ウエハ W が図 2 (b) 中の上方にずれれば超音波受信素子 6a 上での集束位置は下方にずれるため、この横シフト量よりフォトレジスト PR の表面のフォーカス位置の変化量を求めることができる。そのため、予めベストフォーカス位置はテストプリント等によって定めておき、そのときに遮音板 6c の開口の中心 (又は振動中心) と超音波の集束位置の中心とを合わせておけばよい。

【0023】図 3 は、一例として超音波受信系 6 からの検出信号を同期検波して得られるフォーカス信号 D とフォトレジスト PR 表面のフォーカス位置 Z との関係を示す。主制御系 14 内で、超音波受信装置 6a からの検出信号を、遮音板 6c の駆動信号で同期整流することによって、フォトレジスト PR 表面での超音波の集束位置 SS に対応して、フォーカス位置 Z に所定範囲でほぼ比例して変化するフォーカス信号 D が生成される。本例では、超音波の集束位置 SS に対応するフォーカス信号 D

は、集束位置SSが投影光学系PLの像面（ベストフォーカス位置）に合致しているときに0になるようにキャリブレーションが行われており、主制御系14は、フォーカス信号Dよりデフォーカス量（ずれ量）を求めることができる。ウエハWのフォーカス位置が上方にある場合には、Zステージ10（ウエハW）を下方に移動し、逆にフォーカス位置が下方にある場合には、Zステージ10（ウエハW）を上方に移動して露光を行うことになる。

【0024】なお、本例では液体7として水（屈折率1.3）を使用したが、液体7として有機溶媒（例えばアルコール、セダー油等）を用いることもできる。この場合には、投影光学系PLの鏡筒3が腐食しにくくなるという利点がある。また、セダー油（屈折率1.5）を用いる場合には、その屈折率が1.5と大きく、露光光を実質的に短波長化することができる。

【0025】なお、フォーカス位置の検出については、超音波射出系5に複数の開口を有する遮音板を配置し、フォトレジスト表面の複数点での各フォーカス位置を検出するようにしてもよく、あるいは、大きな開口を有する遮音板を超音波射出系5内に配置し、且つ複数の開口を有する遮音板を超音波受信系6内に配置して、同様に複数点での各フォーカス位置を検出するようにしてもよい。

【0026】なお、上記の実施の形態では、超音波を用いてウエハのフォトレジスト表面のフォーカス位置を検出したが、超音波を用いてフォトレジスト表面の傾斜角を検出するレベリングセンサを用いてもよい。このレベリングセンサでは、ウエハの表面にはほぼ平行に進む超音波を照射して、反射される超音波の集音位置を検出すればよい。

【0027】なお、本発明は上述の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得ることは勿論である。

【0028】

【発明の効果】本発明の投影露光装置によれば、マスクのパターン像を液体を介して基板の表面に露光するため、基板表面における露光光の波長を実質的に空気中ににおける波長の液体の屈折率の逆数倍に短波長化できる。また、超音波方式の面位置検出装置により基板表面の光軸方向の位置を検出するため、光学式の面位置検出装置では面位置の検出が困難な液体中においても、その位置を高精度に検出することができる。

【0029】また、面位置検出装置が、感光材料の表面の投影光学系の光軸方向の位置を検出する場合には、その検出情報に基づいて投影光学系の像面に対してその感

光材料の表面を高精度に合わせ込むことができる。また、投影光学系の基板側の光学素子の先端部とその基板の表面との間を満たすように液体が供給される場合には、露光光を空気中の $1/n$ 倍（nは液体の屈折率）に短波長化できる、また、投影光学系の鏡筒が液体に接触しないため、投影光学系の鏡筒が腐食しにくくなるという利点がある。

【0030】また、液体が、水である場合には、その入手が容易であるという利点がある。液体が、有機溶媒（例えばアルコール、セダー油等）である場合には、投影光学系の鏡筒が腐食しにくいという利点がある。さらに、液体としてセダー油を用いる場合には、その屈折率が1.5と水（屈折率1.3）等に比べて大きく、露光光をより短波長化することができる。

【0031】また、基板を保持してこの基板を投影光学系の光軸に垂直な平面上で位置決めする基板ステージと、面位置検出装置の検出結果に基づいてその基板の投影光学系の光軸方向の位置を制御する高さ制御ステージとを備える場合には、投影光学系の像面を基板表面上の露光位置に合わせ込むことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】（a）は本発明の実施の形態の一例の投影露光装置を示す概略構成図、（b）は図1（a）の側壁8近傍を示す拡大図である。

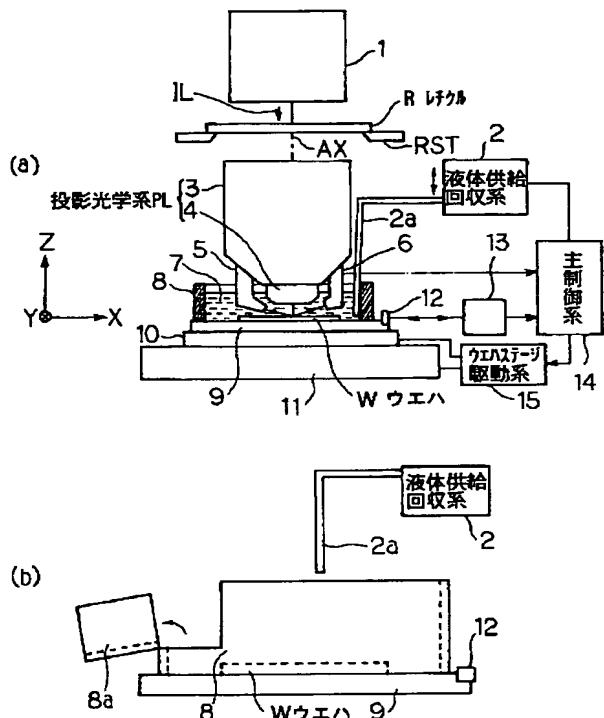
【図2】（a）は図1（a）の投影露光装置下部の構成を示す部分拡大図、（b）は図2（a）のB部の拡大図である。

【図3】ウエハW上のフォトレジスト表面のフォーカス位置Zとフォーカス信号Dとの関係を示す図である。

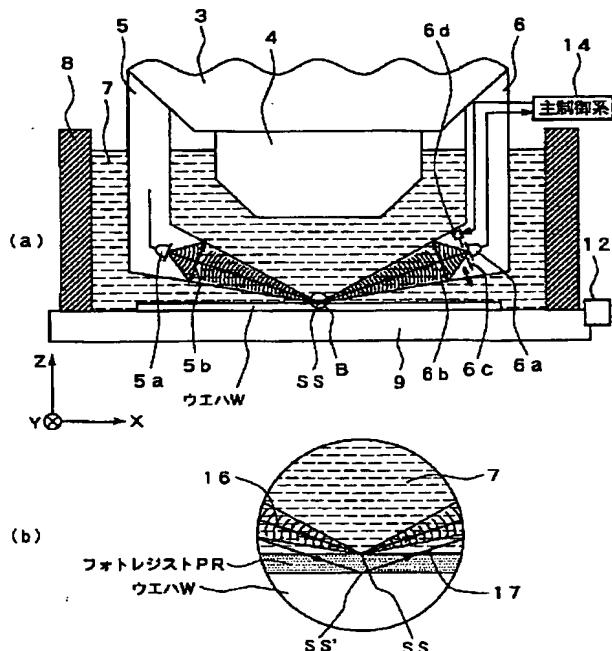
#### 【符号の説明】

- W ウエハ
- R レチクル
- PL 投影光学系
- 1 照明光学系
- 2 液体供給回収系
- 3 鏡筒
- 4 レンズ
- 5 超音波射出系
- 6 超音波受信系
- 7 液体
- 8 側壁
- 9 試料台
- 10 Zステージ
- 14 主制御系
- 15 ウエハステージ駆動系

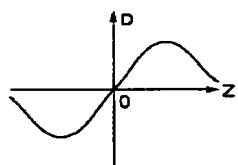
【図1】



【図2】



【図3】



**BEST AVAILABLE CO.**